

NPN エピタキシャル形シリコントランジスタ / NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR

高周波増幅用 / High Frequency Amplifier

通信工業用 / Industrial Use

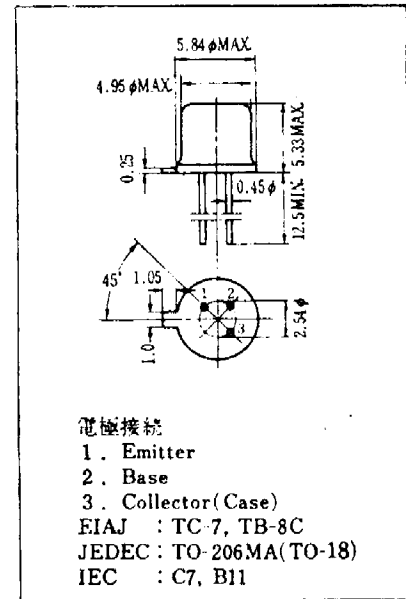
特徴 / FEATURES

- ・高耐圧です。V_{CEO}: 40V, V_{EBO}: 8.0V
High breakdown voltage.
- ・直流電流増幅率が高い。h_{FE}: 80~240
High DC current gain.
- ・高周波増幅はもとよりスイッチング、低周波増幅などにも適します。
Suitable for switching and LF amplifiers as well as HF amplifiers.

絶対最大定格 / ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T_a=25℃)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V _{CBO}	60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEO}	40	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EBO}	8.0	V
コレクタ電流	I _C	200	mA
全損失	P _T	300	mW
ジャンクション温度	T _J	150	℃
保存温度	T _{stg}	-65~+150	℃

外形図 / PACKAGE DIMENSIONS
(Unit:mm)



電気的特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_a=25℃)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I _{CBO}	V _{CB} =40V, I _E =0			0.5	μA
エミッタシャ断電流	I _{EBO}	V _{EB} =5.0V, I _C =0			0.5	μA
直流電流増幅率	h _{FE1}	V _{CE} =1.0V, I _C =10mA	80	150	320	
直流電流増幅率	h _{FE2}	V _{CE} =1.0V, I _C =100mA	30	75		
コレクタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C =100mA, I _B =10mA		0.12	0.70	V
ベース飽和電圧	V _{BE(sat)}	I _C =100mA, I _B =10mA		0.85	1.20	V
利得帯域幅積	f _T	V _{CE} =10V, I _E =-10mA	150	250		MHz
コレクタ容量	C _{ob}	V _{CB} =10V, I _E =0, f=1.0MHz		3.4	5.5	pF
ターンオン時間	t _{on}			95		ns
蓄積時間	t _{stg}	測定回路図参照/See test circuit		190		ns
ターンオフ時間	t _{off}			240		ns

h_{FE} 区分 / h_{FE} Classification

h_{FE1} / 80~130 110~170 150~240 200~320



NJ Semi-Conductors reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by NJ Semi-Conductors is believed to be both accurate and reliable at the time of going to press. However, NJ Semi-Conductors assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use. NJ Semi-Conductors encourages customers to verify that datasheets are current before placing orders.

Quality Semi-Conductors